Research center for photovoltaics

Kamei, APL <u>64</u>, 2712 (1994). SP

Ohta, APL 76, 2740 (2000). PLD

Kamei, TSF 392, 265 (2001). SP

Koida, APL 89, 082104 (2006) PLD

Kato, JCG <u>237-239</u>, 538 (2002). MBE

Nakahara, JJAP 43, L180 (2004). MBE

Sans, Super. Micro. <u>39</u>, 282 (2006). PLD

SP:sputtering

Makino, APL <u>87</u>, 022101 (2005). PLD

Ohta, JAP <u>91</u>,3547(2002). PLD

■ GZO epi

Taga, JAP <u>80</u>, 978 (1996). EB

Carrier density (cm⁻³)

高μ・低N⇒低フリーキャリア吸収

低温製造(170~200°C)

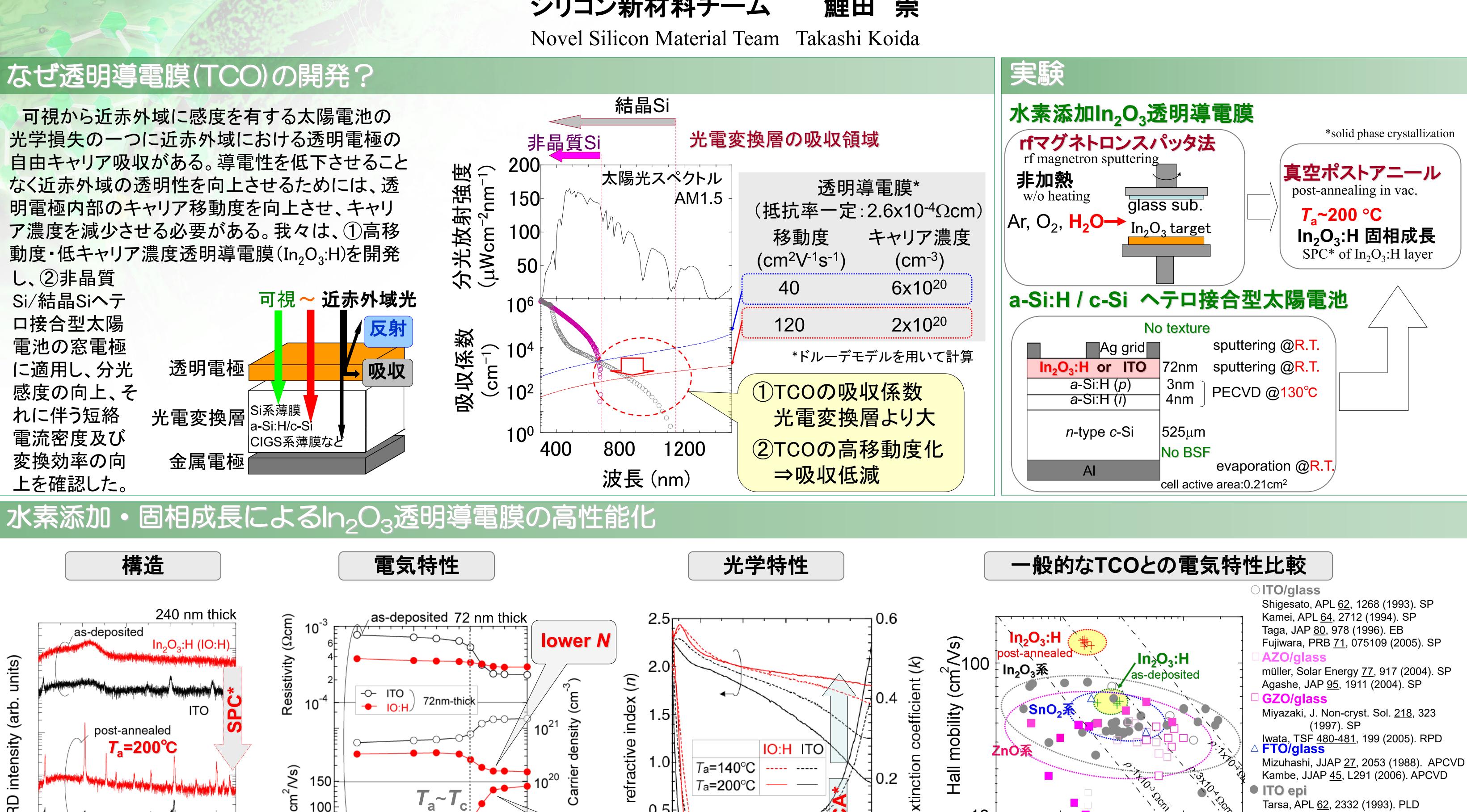
低抵抗ITOに比べ高抵抗

特徴

高性能透明導電膜の開発

Development of high-mobility transparent conductive oxide

シリコン新材料チーム



a-Si:H/c-Si ヘテロ接合型太陽電池の窓電極に適用

Annealing temperature (°C)

低キャリア濃度化

高移動度化

60

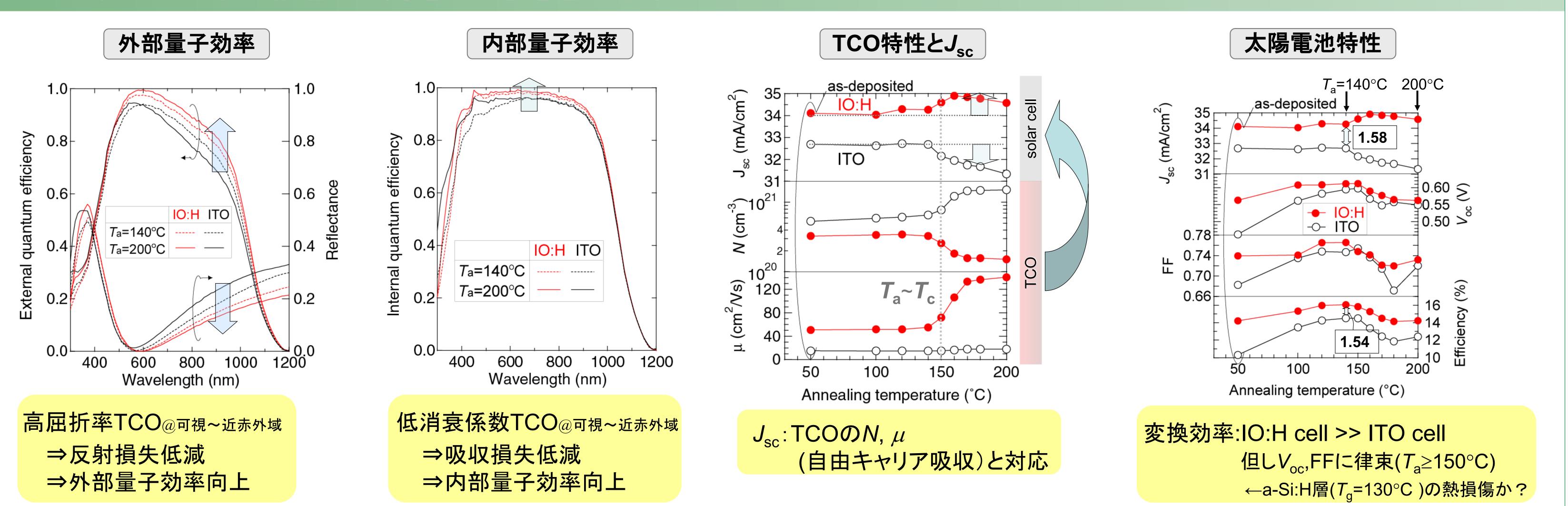
50

2θ (°)

固相成長

 $(\geq 150^{\circ}\text{C}:T_c)$

*solid phase crystallization



1000 1200

800

低自由キャリア吸収

(高屈折率・低消衰係数@可視~近赤外域)

*free carrier absorption

Wavelength (nm)

まとめ

一般の透明導電膜(ITO, ZnO系, SnO₂系)に比べ、著しく近赤外域の透明性に優れたIn₂O₃:H透明導電膜を170~200℃の低温プロセスで作製

- □ 近赤外域に感度を有する光電変換素子・受光素子の感度向上期待
 - T. Koida, H. Fujiwara, and M. Kondo, Jpn. J. Appl. Phys. <u>46</u>, L685 (2007).; J. Non-cryst. Solids <u>354</u>, 2805 (2008).

higher μ

In₂O₃:Hをa-Si:H/c-Siへテロ接合型太陽電池の窓電極に適用:TCOによる反射・吸収損失低減⇒分光感度、短絡電流密度、及び変換効率の向上確認

- ⟨□ TCOの可視~近赤外域の光学定数(n,k)に起因(低自由キャリア吸収に起因)
 - T. Koida, H. Fujiwara, and M. Kondo, Appl. Phys. Express 1, 041501 (2008).

本研究の一部は産総研内部予算、ハイテクものづくりプロジェクト「高機能透明導電膜による薄膜太陽電池モジュール高効率化技術の実証(平成17年4月~平成19年3月)」の援助を受けて行われた。

